附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组别 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 第一组 | 国标委发[2021]12号20210888-T-469 | 碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试 共焦点微分干涉法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]23号20213238-T-469 | 碳化硅晶体材料缺陷图谱 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]23号20213239-T-469 | 蓝宝石图形化衬底片 | 广东中图半导体科技股份有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]41号  20214648-T-469 | 高纯镓 | 有研国晶辉新材料有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2022]17号  20220134-T-469 | 碳化硅外延片 | 南京国盛电子有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2021]41号  20214653-T-469 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第1部分：缺陷分类 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]41号  20214649-T-469 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第2部分：缺陷的光学检测方法 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]41号  20214654-T-469 | 半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第3部分：缺陷的光致发光检测方法 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 预审 |
|  | 第二组 | 国标委发[2021]41号20214650-T-469 | 硅中代位碳含量的红外吸收测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 预审 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0109T-YS | 硅材料中氢含量的测定 惰性气体熔融热导法 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0250T-YS | 颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0470T-YS | 多晶硅生产用石墨制品表面杂质含量的测定 电感耦合等离子体光谱法 | 新疆协鑫新能源材料科技有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0248T-YS | 多晶硅还原炉尾气成分的测定 气相色谱法 | 青海亚洲硅业多晶硅有限公司 | 讨论 |